

Руководитель ОП

к.т.н

Н.К. Куракина

Составители:

д.т.н.профессор

Г.А.Шнеерсон

д.т.н, профессор

В.В. Титков

д.т.н, профессор

С.И. Кривошеев

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию Научно-техническим советом (протокол № 5 от «21» марта 2022 г.).

1. Область применения и нормативные ссылки

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных государственных требований по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Структура вступительного экзамена

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.

Программа содержит перечень тем (вопросов) по специальной дисциплине соответствующей научной специальности **01.04.13 Электрофизика и электрофизические установки** Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух блоков:

- теоретический экзамен, проводимый очно в письменной и/или устной форме (максимальный балл – 100);
- портфолио (максимальный балл – 100).

Минимальное количество баллов для теоретического экзамена составляет 50 баллов.

При получении по теоретическому экзамену результата ниже минимального балла, портфолио не рассматривается и не суммируется с результатом теоретического экзамена.

2.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио

Максимальная возможная оценка за индивидуальные достижения (портфолио) составляет 100 баллов.

Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может представить следующие документы, подтверждающие его достижения:

- a. Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования. Подтверждается представлением программы конференции, диплома (сертификата) участника.
- b. Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных копий подлинников, ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования.
- c. Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты на изобретения, патенты на полезные модели, и проч.
- d. Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах. Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы абитуриента.

Перечень достижений портфолио, учитываемых при приеме на обучение

| № п/п | Индивидуальное достижение | Подтверждающий документ | Количество баллов за каждое достижение |
|-------|---|--|--|
| 1. | Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе): | Копия статьи с выходными данными журнала, DOI, URL | |
| | в журналах перечня ВАК; | | 10 |
| | в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу данных RSCI) Q1 или Q2; | | 25 |
| | в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу данных RSCI) Q3 или Q4. | | 15 |
| 2. | Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, тематика которых соответствует направлению подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он являлся: | Копия подписанного соглашения с грантодателем | |
| | руководителем | | 10 |
| | исполнителем | | 5 |
| 3. | Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности: | Копия патента или свидетельства | |
| | – патент на изобретение; | | 10 |
| | – патент на полезную модель; | | 7 |
| | – свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; | | 5 |
| | – свидетельство о государственной регистрации базы данных; | | 5 |
| | – свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных микросхем. | | 5 |

| № п/п | Индивидуальное достижение | Подтверждающий документ | Количество баллов за каждое достижение |
|-------|--|--|--|
| 4. | Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему. Тематика публикации должна соответствовать научной специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе: | Копии материалов конференций (тезисов докладов) с приложением титульных листов, DOI, URL (при наличии) | |
| | за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus (индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или скриншотом из базы данных). | | 5 |
| | за прочие конференции. | | 3 |
| 5. | Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в аспирантуру. | Копия диплома | 3 |

Оценка индивидуальных достижений проводится на собеседовании.

2.2. Структура и процедура проведения теоретического экзамена

Максимальная возможная оценка за теоретический экзамен составляет 100 баллов. Собеседование состоит из двух частей.

1) Ответ на вопросы в соответствии с научной специальностью будущей научно-исследовательской работы (диссертации).

Абитуриент выбирает билет, содержащий два вопроса из представленных в программе собеседования тем.

Абитуриенту предоставляется 30 минут на подготовку. В ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы.

2) Беседа по планируемому направлению исследований. Абитуриенту необходимо раскрыть следующие вопросы: предполагаемая тема научно-исследовательской работы, формулировка проблемы, цели ее исследования, новизна. В ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы.

2.3. Перечень тем для теоретического экзамена

1. Термодинамические свойства газа и плазмы
2. Элементы механики сплошной среды и теории теплопроводности
3. Поля и переходные процессы в электрофизических установках
4. Мощная импульсная энергетика и высоковольтная импульсная техника.

2.4. Перечень вопросов для теоретического экзамена

1. Виды распределения частиц при термодинамическом равновесии. Квантовые статистические распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна
2. Химический потенциал. Формула Саха..
3. Неравновесные состояния. . Принципы работы лазера.
4. Столкновения частиц в газах и в плазме..
5. Понятие о дифференциальном сечении столкновения Частота столкновений и длина пробега.
6. Взаимодействие заряженных частиц. Масштаб разделения зарядов.
7. Рассеяние на Кулоновском потенциале, дифференциальное сечение столкновения в плазме.
8. Проводимость плазмы, формула Спитцера.
9. Электронные лавины и лавинно-стримерный переход.
10. Искровой разряд. Области применимости и особенности моделей Брагинского и Ромпе-Вайцеля.
11. Основные положения механики сплошной среды
12. Уравнение неразрывности
13. Уравнение движения сплошной среды
14. Уравнение энергии и полная система уравнений механики сплошной среды. Примеры движений сплошной среды: акустическое приближение, приближение несжимаемой жидкости
15. Ударные волны в сплошной среде. Уравнения Рэнкина-Гюгонио. Ударная адиабата.
- 2.5. Элементы механики деформируемого твердого тела. Тензоры напряжений и деформаций и связь между ними.
16. Стационарная теплопроводность. Примеры решения уравнения стационарной теплопроводности
17. Нестационарная теплопроводность.
18. Теплообмен с излучением. Испускание и поглощение излучения
19. Типовые конфигурации магнитных систем с заданным распределением тока.
20. Диффузия импульсного поля в проводящую среду, глубина проникновения, нагрев проводников, магнитное давление.
21. Особенности электромагнитного поля при резко выраженном скин-эффекте.
22. Переходные процессы в системах с меняющейся индуктивностью, используемых для ускорения и деформирования проводников
23. Электрический взрыв проводников
24. Топологические схемы мощных импульсных источников питания. Основные требования к генераторам импульсного тока и напряжения
25. Типы высоковольтных сильноточных коммутаторов, их особенности и ограничения
26. Формирование управляемых импульсов давления с использованием сильных импульсных магнитных полей.
27. Особенности разрушения материалов при электрогидроимпульсном воздействии.
28. Оценка параметров давления в канале разряда в жидкости и энергии разрушения хрупких материалов

29. Особенности измерения больших импульсных токов и магнитных полей. Оценка погрешности измерений.
30. Основные процессы, сопровождающие генерацию сверхсильных импульсных магнитных полей.
31. Методы генерации сверхсильных импульсных магнитных полей.
32. Магнитоимпульсная и электрогидроимпульсное формообразование.
33. Магнитная изоляция и требования к технической реализации

2.5. Критерии оценки теоретического экзамена

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по сто бальной шкале.

100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике.

75 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

50 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

0 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических и практических знаний.

2.6. Список рекомендуемой литературы

1. Титков В.В. Физические основы техники высоких напряжений, сильных магнитных полей и токов/ уч.пособие, СПб, Издательство Политехнического университета, 2011, 181 стр.
2. Шнеерсон .Г.А. Поля и переходные процессы в аппаратуре сверхсильных токов.М.Энергостантоиздат, 1992, 413 стр.
3. Шнеерсон Г.А.Основы техники получения сильных и сверх сильных импульсных магнитных полей./ уч.пособие, СПб, Издательство Политехнического университета, 2010, 309 стр.
4. Я.Б.Зельдович, Ю.П.Райзер Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений, М.: Наука, 1966
5. Э.В.Шпольский Атомная физика т.1, М.:Наука, 1974
6. Кнопфель, Гейнц. Сверхсильные импульсные магнитные поля [Текст] : Методы генерации и физ. эффекты, связ. с созданием импульсных полей мегаэвстедного диапазона / Перевод с англ. Ф. А. Николаева и Ю. П. Свириденко. - Москва : Мир, 1972. - 391 с. : ил.; 22 см.

Приложение

Сведения об достижениях портфолио кандидата для поступления по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбПУ

| (Ф.И.О. кандидата для поступления в аспирантуру) | | | |
|--|---|--|---|
| (научная специальность) | | | |
| № п/п | Индивидуальное достижение | Количество баллов за каждое достижение | Рейтинговая оценка показателя, общий балл |
| 1. | Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе): в журналах перечня ВАК; | 10 | |
| | в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу данных RSCI) Q1 или Q2; | 25 | |
| | в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу данных RSCI) Q3 или Q4. | 15 | |
| 2. | Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, тематика которых соответствует направлению подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он являлся: | | |
| | руководителем, | 10 | |
| | исполнителем. | 5 | |
| 3. | Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности: | | |
| | – патент на изобретение; | 10 | |
| | – патент на полезную модель; | 7 | |
| | – свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; | 5 | |
| | – свидетельство о государственной регистрации базы данных; | 5 | |
| | – свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных микросхем. | 5 | |
| 4. | Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему (тематика публикации должна соответствовать научной специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе): за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus (индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или скриншотом из базы данных); | 5 | |
| | за прочие конференции. | 3 | |
| 5. | Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в аспирантуру | 3 | |
| Суммарный рейтинговый балл | | | |

Кандидат в аспирантуру

(подпись)

(Ф.И.О).

Предполагаемый научный руководитель

(подпись)

(Ф.И.О).

Руководитель образовательных программ по аспирантуре института

(подпись)

(Ф.И.О).